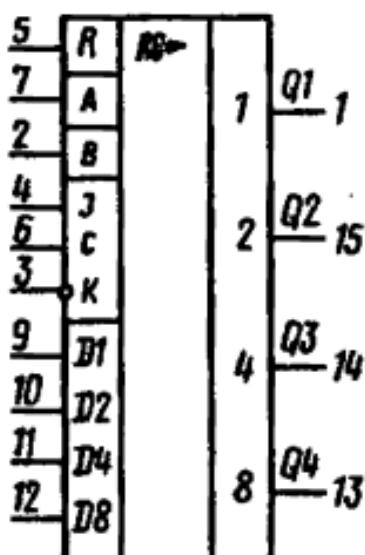


К564ИР9, КР564ИР9В

Микросхемы представляют собой четырехразрядный последовательно-параллельный регистр. Содержат 207 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-23, масса не более 1,5 г и 238.16-2, масса не более 2 г.



Условное графическое обозначение К564ИР9, КР564ИР9В

Назначение выводов: 1 — выход Q_1 ; 2 — вход B ; 3 — вход K ; 4 — вход J ; 5 — вход R ; 6 — вход C ; 7 — вход A ; 8 — общий; 9 —

вход $D1$; 10 — вход $D2$; 11 — вход $D4$; 12 — вход $D8$; 13 — выход Q_4 ; 14 — выход Q_3 ; 15 — выход Q_2 ; 16 — напряжение питания.

Таблица истинности

C	t_{n-1} (входы)			t_n (выходы)	
	J	K	R	Q_{n-1}	Q_n
0	0	X	0	0	0
0	1	X	0	0	1
X	0	0	0	1	0
1	0	0	0	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
X	1	0	0	1	1
X	X	X	0	Q_{n-1}	Q_{n-1}
X	X	X	1	X	0

Примечание. $A=1$ — разрешение параллельной записи числа; $A=0$ — разрешение последовательной записи числа; $B=1$ — прямой выход числа; $B=0$ — инверсный выход числа; D — параллельный вход; Q — параллельный выход.

Электрические параметры

Напряжение питания 3...15 В

Выходное напряжение низкого уровня при воздействии помехи:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≤0,8 В

при $U_{\text{п}}=10$ В ≤1 В

Выходное напряжение высокого уровня при воздействии помехи:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≥4,2 В

при $U_{\text{п}}=10$ В ≥9 В

Ток потребления при $U_{\text{п}}=15$ В ≤20 мкА

Входной ток низкого (высокого) уровня

при $U_{\text{п}}=15$ В ≤0,3 мкА

Входной ток высокого уровня при $U_{\text{п}}=10$ В ≤0,05 мкА

Выходной ток низкого уровня:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≥0,35 мА

при $U_{\text{п}}=10$ В ≥0,85 мА

Выходной ток высокого уровня:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≥0,25 мА

при $U_{\text{п}}=10$ В ≥0,6 мА

Время задержки распространения при включении:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≤800 нс

при $U_{\text{п}}=10$ В ≤360 нс

Время задержки распространения при выключении:

при $U_{\text{п}}=5$ В ≤650 нс

при $U_{\text{п}}=10$ В ≤235 нс

Входная емкость при $U_{\text{п}}=10$ В ≤10 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания 3...15 В

Напряжение на входах -0,2...($U_{\text{п}}+0,2$) В

Температура окружающей среды -45...+85 °C